### *06;12*

# Кластеризация структуры, предшествующая концентрационным фазовым переходам

#### © С.В. Титов, Л.А. Шилкина, Л.А. Резниченко, С.И. Дудкина, О.Н. Разумовская, С.И. Шевцова, Е.М. Кузнецова

Научно-исследовательский институт физики Ростовского государственного университета E-mail: klevtsov@iphys.rnd.runnet.ru

#### Поступило в Редакцию 6 апреля 2000 г.

Исследованы процессы образования и развития объемных кристаллохимических дефектов мезоскопического масштаба (кластеров) — зародышей новых фаз в системах, испытывающих концентрационные фазовые переходы. Показано, что их ступенчатая эволюция в процессе приближения твердых растворов к морфотропной области проходит несколько этапов, которые находят отклик в изменении макроскопических свойств. Высказано предположение о роли кластеров в формировании экстремальных электрофизических параметров рассматриваемых объектов.

В проблеме неоднородности конденсированных сред наибольший интерес в последнее время проявляется к образованию объемных кристаллохимических дефектов мезоскопического масштаба (кластеров), возникающих при ассимиляции и упорядочении вакансий и внедренных атомов. Кластеризация структуры обнаружена во многих оксидных системах, в том числе простых монооксидах, ферритах, неупорядоченных сегнетоэлектрических соединениях, в которых показана ее роль при полиморфных превращениях и формировании макроскопических свойств [1,2].

Цель настоящего исследования — изучение процессов развития кластерных структур — зародышей новых фаз в окрестности концентрационных фазовых переходов (ФП). Объемны исследования — сегнетоэлектрические твердые растворы (ТР) состава (1 - x)NaNbO<sub>3</sub>-*x*PbTiO<sub>3</sub> (1), *x*PbTiO<sub>3</sub>-(1 - x - y)PbZrO<sub>3</sub>- $y \sum (PbB'_{1-\beta}B'_{\beta}O_3)_n$  (B'-Nb, W; B"-Li, Zn,

9

Мg, Ni; n = 4) (2), полученные твердофазным синтезом с последующим спеканием без давления (1) или горячим прессованием (2). В системе (1) рассматривались TP (1), по составу отвечающие двум фрагментам фазовой диаграммы: с  $x = 0.2195 \div 0.305$  (ромбическая PI-область) и  $x = 0.40 \div 0.70$  (тетрагональная T<sub>1</sub>-область), расположенным между морфотропными областями (MO); в системе (2) анализировались TP (2) с  $x = 0.30 \div 0.37$ , принадлежащие ромбоэдрической (Rh), T- и MO-областям.

Экспериментально установлено немонотонное поведение концентрационных зависимостей среднего параметра ( $\bar{a}_2$ ) приведенной перовскитной ячейки, рентгеновской ( $\rho_1$ ) и измеренной ( $\rho_2$ ) плотностей керамических образцов, а также характеристик, определяющих размы-



**Puc. 1.** Зависимости от  $x \bar{a}_1(I), \bar{a}_2(2), a_{T_2}(3), c_{T_2}(4), \rho_2(5), \rho_1(6), \rho_3(7), \Delta(8), \overline{\delta\alpha}_{\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0}(9), \overline{\Delta\alpha}_{\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0}(10), \varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0(11)$  в системах 1 (*a*) и 2 (*b*).

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 18



Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 18

тие  $\Phi\Pi$  ( $\Delta^1$ ) и разброс электрофизических параметров ( $\overline{\Delta\alpha}, \overline{\delta\alpha}^1$ ) (рис. 1). Отмечено также некоторое снижение относительной плотности, свидетельствующее о разрыхлении структуры. Наблюдаемое не может быть объяснено в модели идеальных и даже реальных (со статически распределенными дефектами) ТР. Учитывая, что все рассматриваемые объекты не содержат примесных включений, подобные изменения характеристик могут быть связаны с возникновением и развитием объемных кристаллохимичпских дефектов мезоскопического масштаба (кластеров). Образование последних должно сопровождаться локальными флукатуациями состава, что и подтверждено электроннозондовыми исследованиями (растровый электронный микроскоп микроанализатор Комебакс-микро). В системе (1) выявлены области, обогашенные Pb и Ti, черелующиеся с областями, имеющими их пониженное содержание. Как показывают сканограммы, колебания количеств указанных элементов минимальных вдали (x = 0.40, 0.45) и вблизи (x = 0.70) МО. При x = 0.5 колебания увеличиваются и достигают максимальной величины при x = 0.6.

С целью выяснения природы таких нарушений была детально изучена дифракционная картина рассматриваемых ТР. Анализу подвергались профили брэгтовской и диффузионной составляющих рентгеновского рассеяния. Как свидетельствуют полученные данные, имело место перераспределение интенсивностей между интерференционными максимумами и фоном. Так, в системе (1) слева от концентрационного ФП, происходящего в интервале 0.75 < x < 0.85, при сохранении общей дифракционной картины, характерной для T<sub>1</sub>-структуры TP, тонкая структура интенсивности фона в интервале  $2\theta = 56 \div 57$  grad (Fe<sub>Ka</sub>-излучение) изменяется в зависимости от *x*: при *x* = 0.40 отмечаются слабые колебаний фона, затем (x = 0.45) незначительно возрастает интенсивность фона, далее появляются несколько очень слабых равновеликих диффузных максимумов (x = 0.50) и, наконец, они сливаются в один (x = 0.60), сильно размытый (гало). Одновременно происходит постепенное уменьшение интенсивности отражения 002 основной Т<sub>1</sub>-фазы. Появившийся диффузный максимум, очевидно,

 $<sup>^1</sup>$   $\Delta$  определялось из зависимости диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon$ ) от температуры (T) по формуле  $\Delta = \Delta T/1.633$  [K] [3], где  $\Delta T$  взято на уровне  $\varepsilon = 0.75_{\rm max}$ ; абсолютное ( $\overline{\Delta\alpha}$ ) и относительное ( $\delta\alpha$ ) отклонения величины  $\alpha$  (в нашем случае относительной диэлектрической проницаемости поляризованных образцов  $\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$ ) от среднего значения вычислены по стандартным формулам [4].

является результатом когерентного рассеяния рентгеновских лучей образовавшимися областями мезоскопического масштаба — кластерами. Различие параметров их элементарных ячеек и матрицы позволяет не только проследить за развитием, но и оценить размеры кластеров по полуширинам диффузных максимумов: при x = 0.50-80 Å, при x = 0.60-90 Å, а при  $x \ge 0.75$  на месте диффузного максимума появляется ренгеновская линия, интенсивность которой усиливается, а полуширина уменьшается с ростом х. Установлено, что увеличение среднего межплоскостного расстояния  $(\overline{d}_{002})$  кластера с ростом x происходит с большей скоростью, чем  $d_{002}$  матричной  $T_1$ -фазы. Это свидетельствует о неравномерном распределении PbTiO<sub>3</sub> между матрицей и новой фазой: в последнюю его поступает больше. Принимая во внимание предстоящий при  $x \ge 0.75 \ \Phi\Pi$ , естественно предположить, что обнаруженные кластеры — это зародыши новой T<sub>2</sub>-фазы, образовавшейся в кристаллической T<sub>1</sub>-матрице. Сопоставляя результаты электроннозондового и рентгеноструктурного анализов, можно сделать вывод о том, что в системе (1) уже на расстоянии  $\sim 20 \text{ mol.}\%$  от МО образуется гетерогенная область, с когерентно-дифрагирующими блоками новой фазы мезоскопического масштаба. При этом совпадение положения линий 100 "старой" и новой фаз говорит об общности плоскости (100) матрицы и кластера, что позволяет сделать вывод о когерентности связи последнего с исходной T<sub>1</sub>-структурой. В случае, когда прямое наблюдение за процессом образования кластеров оказывалось невозможным (из-за близости численных значений параметров ячеек основной и зарождающейся фаз и, как следствие, наложения рентгеновских рефлексов), динамика их формирования отслеживается по изменению величины  $\Delta D$ -разности в размерах областей когерентного рассеяния, рассчитанных по полуширине и интегральной ширине дифракционных линий. Возрастание этой величины вдали от МО свидетельствует об увеличении количества кластеров и достижении ими при  $\Delta D$  максимальном, критических размеров, уменьшение ее при приближении к МО отражает факт отрыва кластера от матрицы и автономного развития новой фазы (рис. 2, *a*, *b*).

При сохранении когерентности в процессе роста кластеров в плоскости их сопряжения с матрицей возникают значительные упругие деформации, нарастающие по мере увеличения их размеров и количества. С определенного момента процесс становится лавинообразным, что вызывает резкое возрастание микродеформаций ( $\Delta d/d$ ) вблизи



**Рис. 2.** Зависимости от  $x \Delta d/d$  (1),  $\Delta D$  (2),  $\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$  (3),  $K_p$  (4), в системах I (a) и 2 (b, c). (На рис. 2, a, b в квадратных скобках указаны направления, в которых определялись  $\Delta d/d$  и  $\Delta D$ . На рис. 2, c указаны следующие ступени развития кластерных структур: I, I' — начало образования кластеров Т- и Rh-фаз соответственно; II, II' — достижение кластерами критических размеров; III, III' — начало отрыва кластеров от матрицы; IV, IV' — завершение процесса отрыва кластеров от матрицы. A — однофазная, B — гетерогенная, C — гетерофазная области).



МО. Достигнув предела упругой деформации система переходит в фазу пластической деформации с разрывом когерентной связи исходной и новой фаз и выделением последней в самостоятельную структурную единицу. При этом ввиду определенной анизотропии среды эти разрывы происходят не одновременно, а последовательно, захватывая все большее число кластеров. Это сопровождается резким уменьшением микродеформаций и релаксацией напряжений (рис. 2, *a*, *b*).

Со ступенчатой эволюцией кластеров в процессе изменения состава ТР связано не только аномальное поведение параметров тонкой кристаллической структуры, но и электрофизических свойств вдали и в окрестности МО. Видно (рис. 2, *c*), что "особые" точки (изменения наклона, максимумы, минимумы) на кривых  $\Delta d/d(x)$ ,  $\Delta D(x)$ ,  $\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0(x)$ ,  $K_p(x)$  (коэффициент электромеханической связи) соответствуют определенным стадиям развития кластерных структур. В связи с этим нам представляется, что наряду с установленными в [5] закономерностями

формирования экстремальных свойств ТР вблизи концентрационных ФП дополнительный вклад в этот процесс привносят образующиеся уже вдали от МО мезоскопические неоднородности, обусловленные потерей устойчивости одной из фаз [6], приводящей к частичному разупорядочению исходной структуры.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследования, грант № 99-02-17575.

## Список литературы

- [1] Архаров В.И. // Проблемы современной физики. Л.: Наука, 1980. С. 357-382.
- [2] Бунина О.А., Захарченко И.Н., Тимонин П.Н., Сахненко В.П. // Кристаллография. 1975. Т. 40. № 4. С. 708–712.
- [3] Боков А.А. // ЖЭТФ. 1997. Т. 111. № 5. С. 1817–1832.
- [4] Касандрова О.Н., Лебедев В.В. / Обработка результатов наблюдения. М.: Наука, 1970. 104 с.
- [5] Фесенко Е.Г., Данцигер А.Я., Разумовская О.Н. // Новые пьезокерамические материалы. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1983. 158 с.
- [6] Гуфан Ю.М. Структурные фазовые переходы. М.: Наука, 1982. 304 с.